

第十二届中国半导体行业协会半导体分立器件年会 在贵阳圆满落幕

由中国半导体行业协会和贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会共同主办的“第十二届中国半导体行业协会半导体分立器件年会暨 2018 年中国半导体器件技术创新及产业发展论坛”于 7 月 25 日在贵阳市圆满落幕。大会由中国半导体行业协会半导体分立器件分会赵小宁秘书长主持，中国半导体行业协会宫承和常务副秘书长和贵阳国家高新区管委会盛园园副主任出席会议并致辞，中国电子科技集团公司第十三研究所蔡树军副所长致欢迎辞，共有来自全国各地 420 余人参与此次盛会。

西安电子科技大学郝跃院士以《第三代半导体器件和材料发展与展望》为题，详尽介绍了第三代半导体器件和材料的发展状况，并指出目前我国在第三代半导体器件技术上与国际水平同行，但在技术与产业相结合上还远远落后，需要在材料上下更大的功夫。中国电子科技集团公司原副总经理赵正平研究员在《极宽禁带半导体 Ga_2O_3 微电子学的进展》中，介绍当今国际 Ga_2O_3 材料与器件的发展状况，虽说与应用还存在一定的距离，但国内前沿技术研究绝不能放弃。中国电子科技集团公司第十三所副所长蔡树军研究员以详实的数据对当前中国半导体技术水平与国际先进制程进行了全方位对比，认清差距与自身优势，提出了中国半导体发展策略。中国电源学会理事长徐德鸿教授在《电力电子技术与应用展望》中指出，“应对气候变化是 21 世纪对电力电子技术和产业发展的最大推动力”，功率电子器件是支撑

未来电网、电气化交通、工业节能和数据中心电源系统节能的核心元件。希望半导体分立器件行业同仁们制造出更好的分立器件应用在电力电子系统中。另外，电子科技大学的罗小蓉教授和贵州大学的丁召教授分别带来了《低功耗、高速 IGBT 典型技术与新结构》和《贵州大学电子学科的发展历程现状和未来发展的思考》，和与会代表们分享。在六个技术分会场，共有 90 余篇论文与会交流。

交流寻求机遇，创新成就未来，期待下届年会再见！



贵阳第十二届半导体分立器件年会会场